	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XK2600NA20L(单胞)	文件编号	XS-R-364
	快恢复二极管	版本号	18-A2-05
		页码	1/3

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

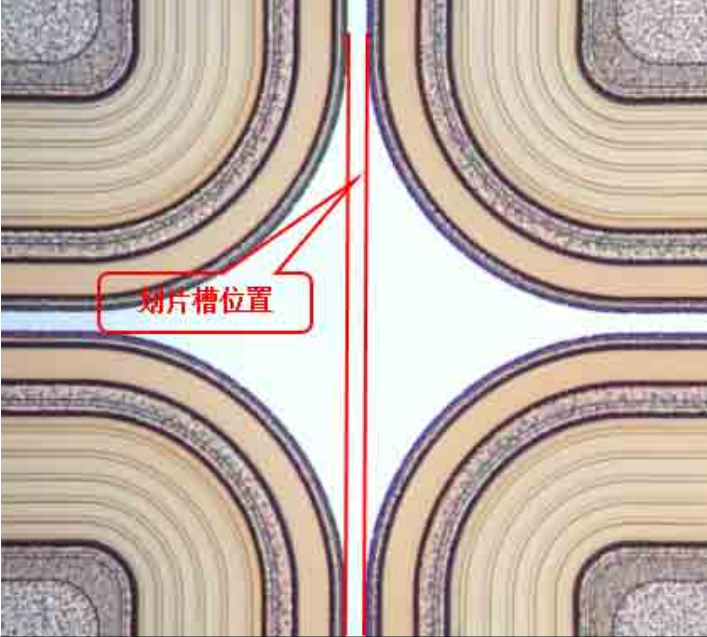
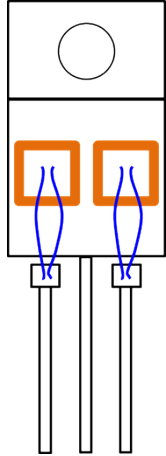
用 W1XK2600NA20L 封装的成品管可用于 PFC、UPS、超声清洗机、电焊机等设备上进行大电流整流。

1.2 主要特点

- 高速开关
- 低功耗
- 高可靠性

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸		2.60 mm×2.60 mm
			102.36 mil×102.36 mil
	芯片厚度 (μm) (推荐)		260±20
	▷划片道尺寸 (μm)		46
	键合区面积 (μm ²)	正面	1550×1550
	正面电极 (阳极)	金属	铝
		厚度	7.5±1.0
	背面电极 (阴极) (推	表层金属	银
	硅片直径 (mm)		φ 125
	装料要求 (推荐)		焊料
	☆键合要求 (推荐)		2 根 φ 380 μm 铝线 (单

 <p>划片槽位置</p>	
▷划片道示意图	☆封装示意图 (推荐)


江阴新顺微电子有限公司

地 址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：Http://www.xs-elec.com

电 话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XK2600NA20L(单胞)	文件编号	XS-R-364
	快恢复二极管	版本号	18-A2-05
		页码	2/3

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

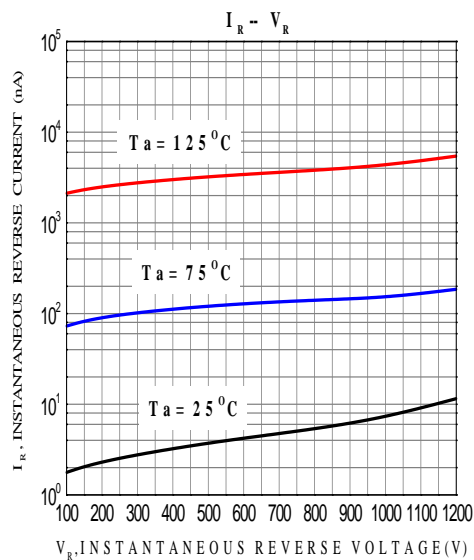
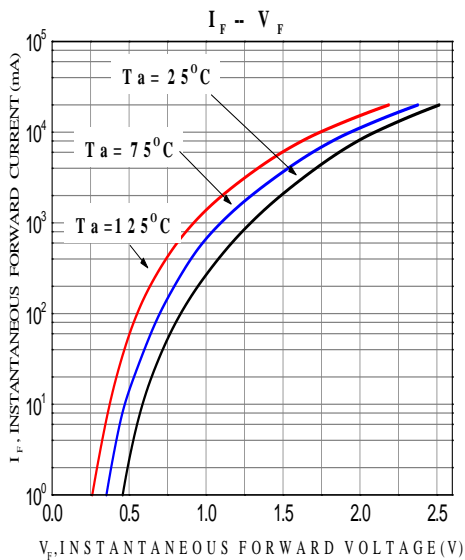
参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	V_{RM}	1200	V	推荐封装形式: TO-3P 推荐成品型号: MUR20120PT
正向电流	$I_{F(AV)}$	10 (单胞)	A	
正向浪涌电流(在推荐键合要求下)	I_{FSM}	110 ($t=8.3\text{ms}$, Sine)	A	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_R=100\mu\text{A}$	1200	—	—	V
反向电流	I_R	$V_R=1200\text{V}$	—	0.03	1	μA
正向电压	V_F	$I_F=10\text{A}$	—	2.0	2.4	V
反向恢复时间	t_{rr}	$I_F=0.5\text{A}$, $I_R=1.0\text{A}$, $I_{rr}=0.25\text{A}$	—	—	50	ns
总电容	C_{tot}	$V_R=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$	—	75	—	pF

3.3 典型特性曲线




江阴新顺微电子有限公司

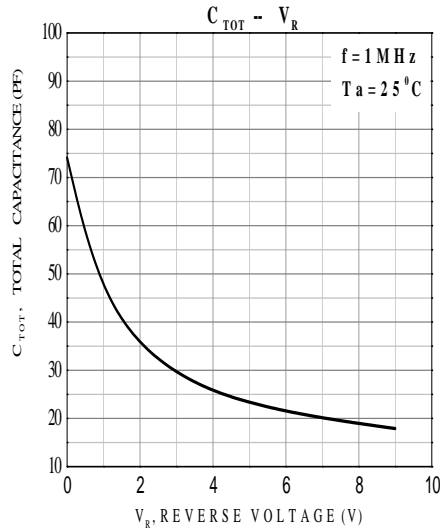
地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XK2600NA20L(单胞)	文件编号	XS-R-364
	快恢复二极管	版本号	18-A2-05
		页码	3/3



注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地 址：江苏省江阴市长山大道 78 号
电 话：(0510) 86851182

网 址：[Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)
传 真：(0510) 86851532